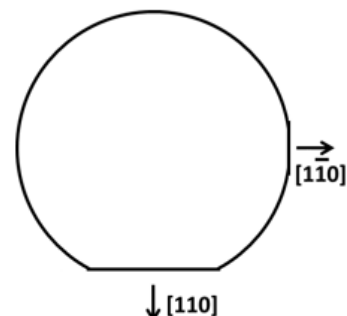


## GalnP/GaInAsP 红外半导体激光器外延片说明书

### 一、基本信息

直径	3/4inch
厚度	450±25 um <sup>①</sup>
PL 波长	780-860nm
表面取向	(100) 15° Off Toward <111> ±0.5°
定位边标准	US
衬底 EPD	<500 cm <sup>-2</sup>



外延片示意图

### 二、外延结构

名称	材料	厚度(Å)	掺杂浓度 (cm <sup>-3</sup> )
欧姆接触层	GaAs	2000~3000	>1E+19
带隙过渡层	GaInP	200~500	1~5E+18
P 限制层	AlGaInP	9000~11000	1~2E+18
波导层	GaInP	3000~6000	-
有源区	InGaAsP	~100	-
波导层	GaInP	3000~6000	-
N 限制层	AlGaInP	9000~11000	0.5~1E+18
过渡层	GaAs	~3000	1~4E+18

说明：①可提供定制尺寸及厚度的外延片。

②部分参数可以根据客户要求进行定制。